K12----K110

SCHOTTKY DIODE

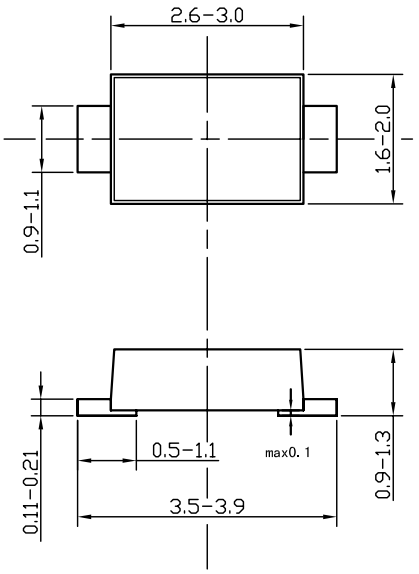
技术参数规格书

特性:

- 超薄小型外观
- 专为SMT自动贴片设计
- SKY芯片
- 低正向电压
- 低反向漏电
- 耐瞬间正向浪涌电流冲击
- 高耐焊接温度:引脚耐焊接热条件为260C/10秒
- 符合EU RoHS 2002/95/1指令要求

封装尺寸规格

SOD-123FL



mm

外观参数:

- 封装:符合JEDEC DO-219AB,玻璃钝化芯片结合外部塑封
- 引脚:表面镀锡,可焊性参照MIL-STD-750,Method 2026
- 标准包装主:8mm包装带(EIA-481)
- 极性标志:激光打印,阴极标有阴极线条指示

最大额定值与电性能参数:

- 环境温度25C，除非另有说明
- 单相半波60Hz，电阻性或电感性负载
- 电容性负载时降低额定电流20%

		符号	K12	K13	K14	K15	K16	K18	K19	K110	单位
最大可重复反向电压		V_{RRM}	20	30	40	50	60	80	90	100	V
最大均方根值		V_{RMS}	14	21	28	35	42	56	63	70	V
最大直流阻断电压		V_{DC}	20	30	40	50	60	80	90	100	V
最大正向平均整流电流 @ TL =105℃		$I_{(AV)}$	1.0								A
峰值正向浪涌冲击电流 8.3mS单一正弦半波		I_{FMS}	30								A
最大正向电压 @IF=1.0A		V_F	0.55			0.75		0.85			V
最大反向电流	T_A=25℃	I_R	0.5								mA
	T_A=125℃		20			10					
工作结温		T_J	(-55to+150)								℃
存储温度		T_{STG}	(-55to+150)								℃

Download from alldatasheet.com

典型特性曲线图:

Fig.1 Forward Current Derating Curve

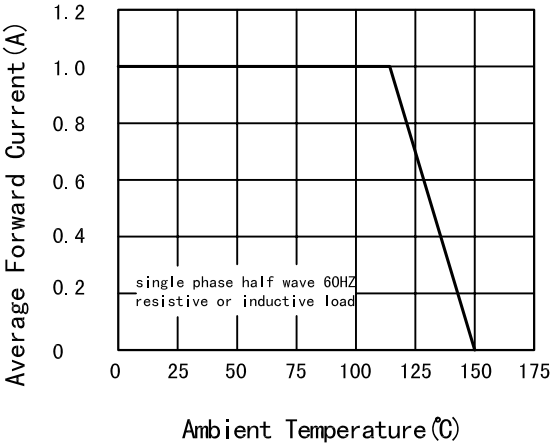


Fig.2 Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current

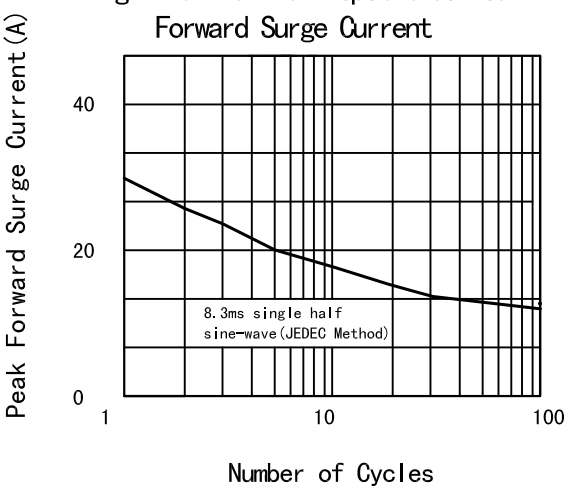


Fig.3 Typical Instantaneous Forward Characteristics

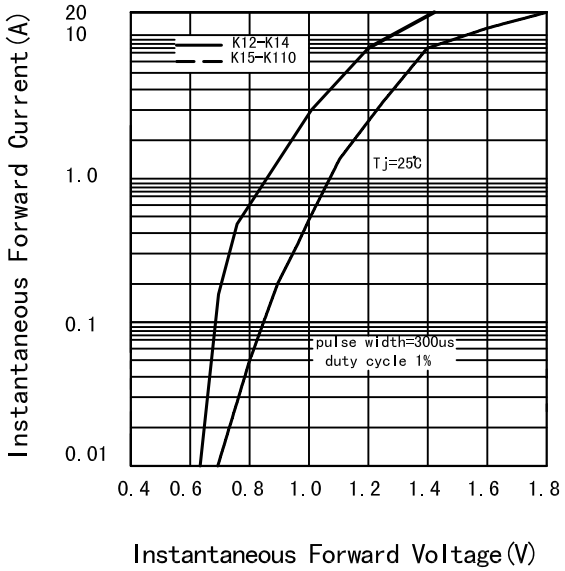


Fig.4 Typical Reverse Characteristics

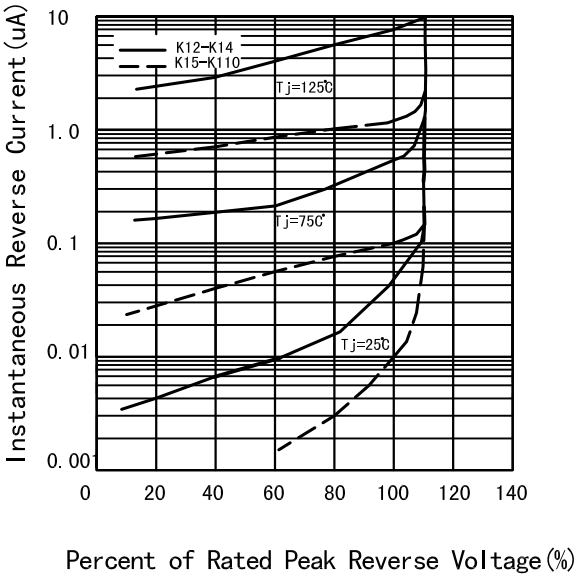
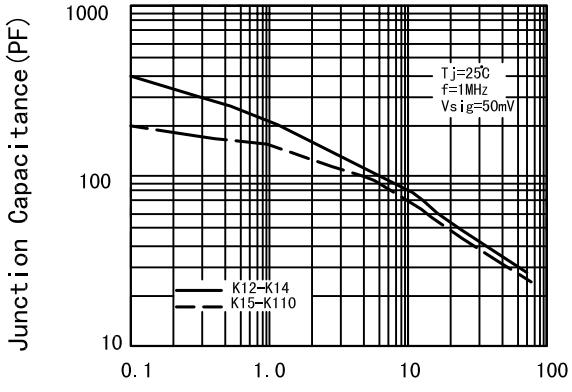


Fig.5 Typical Junction Capacitance



Download from alldatasheet.com